

# 2014年3月期 第2四半期(2013年4月～9月)

## 東京エレクトロン 決算説明会

内容:

➤ 第2四半期連結決算の概要

取締役執行役員 原田 芳輝

➤ 2014年3月期 業績予想修正および重点施策の進捗状況

代表取締役会長兼社長、CEO 東 哲郎

2013年10月29日

# 第2四半期連結決算の概要

---

取締役執行役員 原田 芳輝

2013年10月29日

# 業績サマリー

	2013年3月期		2014年3月期	対前年上期 増減	(億円) (ご参考) 7/30発表の 2014年3月期 上期予想
	上期	下期	上期		
売上高	2,666	2,306	2,545	-4.5%	2,520
売上総利益 <small>下段: 売上総利益率</small>	856 32.1%	731 31.7%	800 31.5%	-6.5%	
販管費	734	727	818	+11.5%	
営業利益 <small>下段: 営業利益率</small>	122 4.6%	3 0.2%	-18 -0.7%	—	-65 -2.6%
税前利益	155	22	-3	—	-55
当期純利益	60	-0	24	-59.3%	-10
研究開発費	374	358	384	+2.7%	
設備投資額	128	88	67	-47.7%	
減価償却実施額	117	148	127	+8.1%	

## 半導体設備投資の回復が第2四半期から鮮明となり、増収に転じた

1. 当社の主力製品である半導体製造装置及びFPD製造装置の輸出売上は、原則円建てで行われます。一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。
2. 利益率および増減率は、1円単位の金額をもとに計算しています

2

# 部門別売上高

(億円)

	2013年3月期				2014年3月期		(ご参考) 7/30発表の 2014年3月期 上期予想
	上期		下期		上期		
	売上高	構成比	売上高	構成比	売上高	構成比	
SPE	2,146	81%	1,773	77%	1,947	77%	1,960
FPD	91	3%	109	5%	93	4%	100
PVE	0	0%	0	0%	32	1%	40
EC/CN	424	16%	421	18%	467	18%	420
その他	2	0%	2	0%	2	0%	-
合計	2,666	100%	2,306	100%	2,545	100%	2,520

■ SPE  
(半導体製造装置)

ファウンドリ及びメモリ投資の活発化により、第2四半期より売上が急回復

■ FPD  
(FPD製造装置)

モバイルパネル向け装置売上が中心

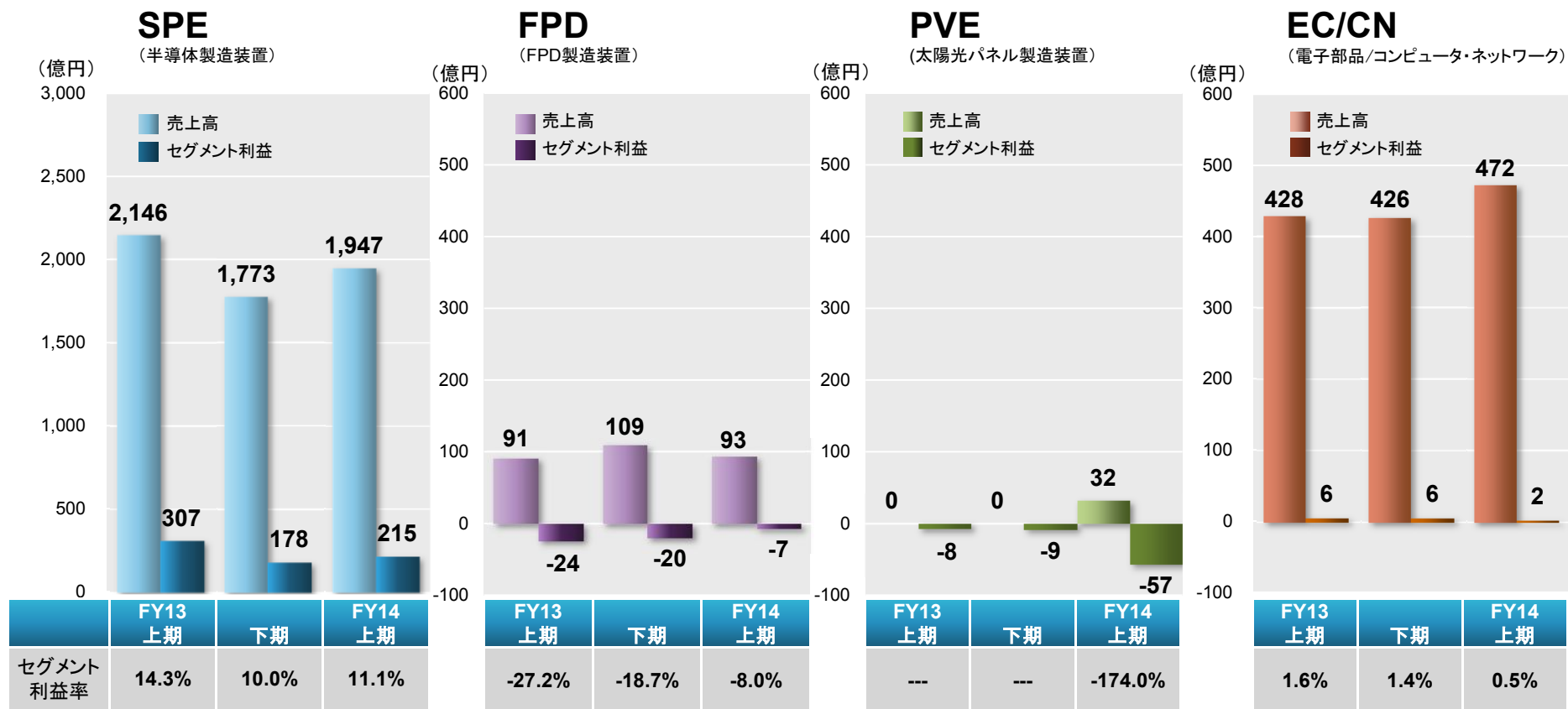
■ PVE  
(太陽光パネル製造装置)

納入済み装置の工事進行基準による売上が中心

■ EC/CN  
(電子部品/コンピュータ・ネットワーク)

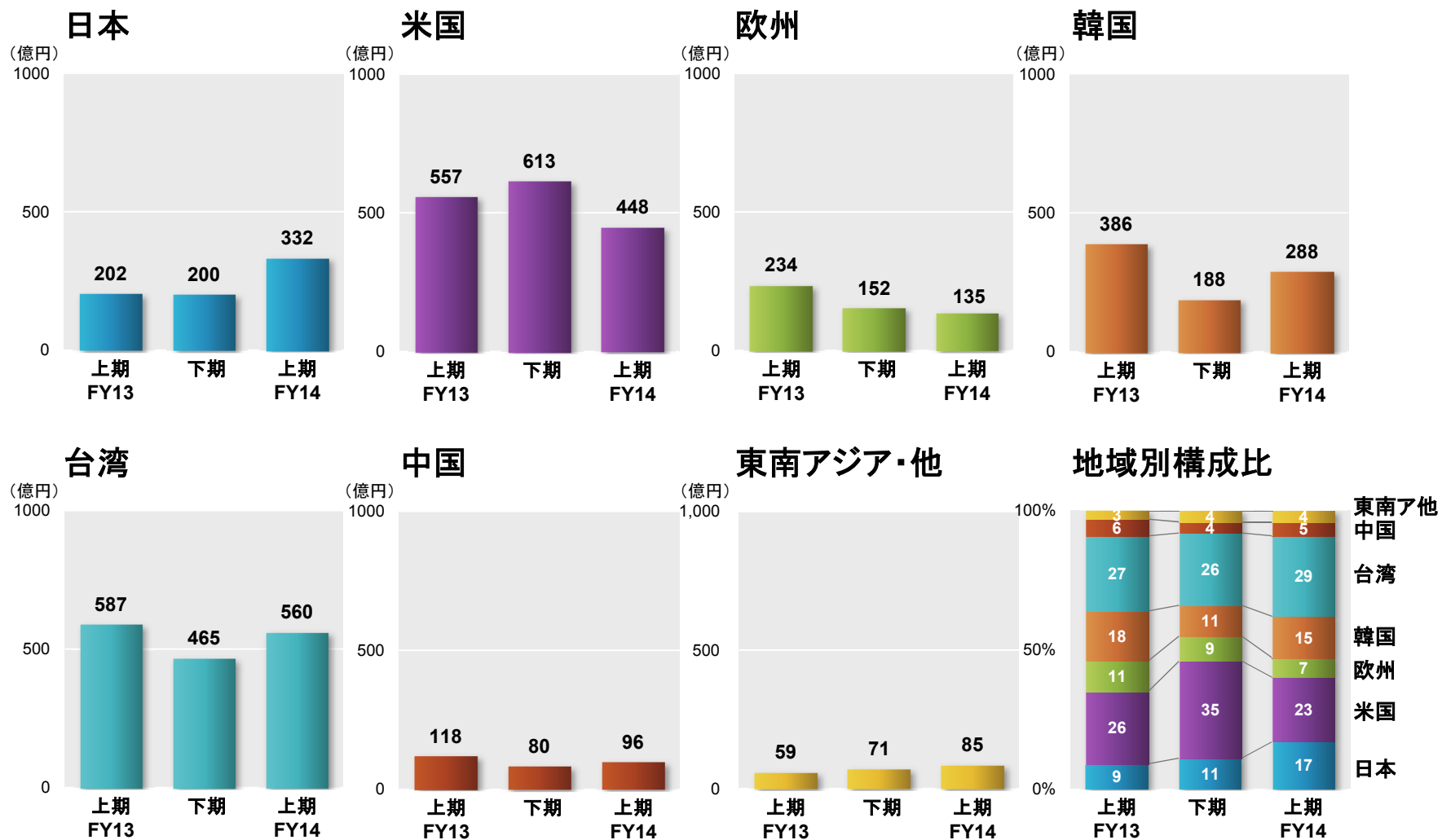
半導体製品の商権拡大により、国内売上、海外売上ともに伸長

# セグメント情報



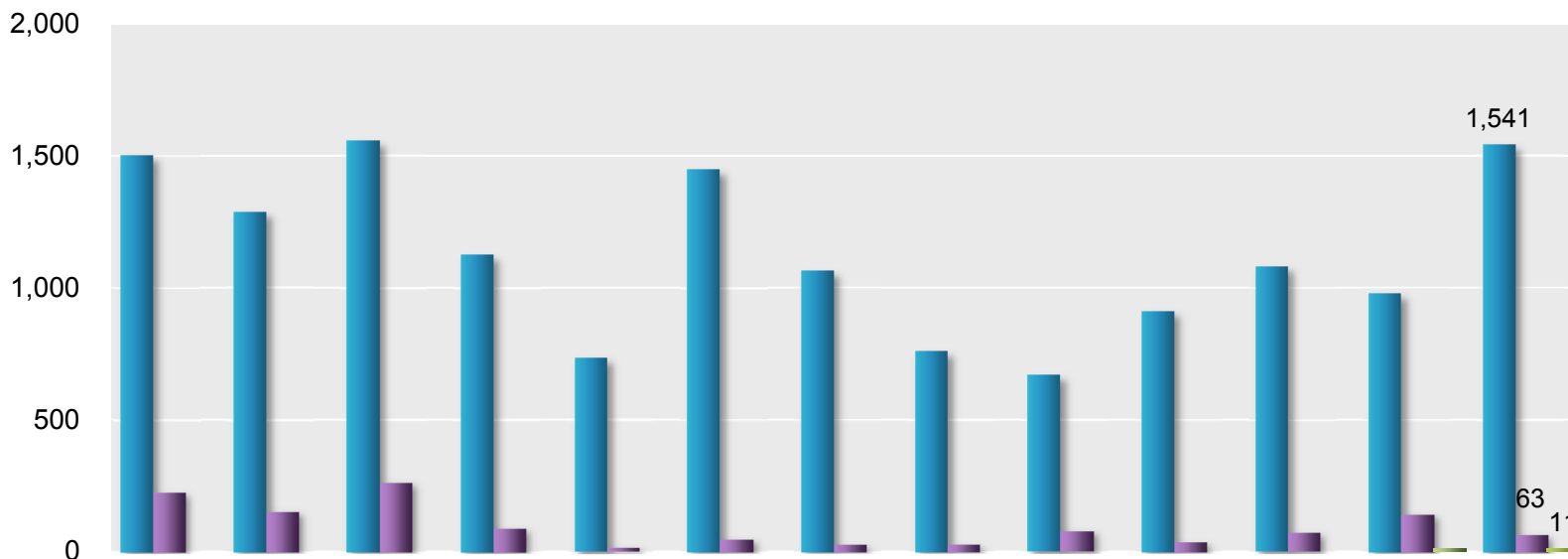
- 従来のFPD/PVEセグメントを、当第1四半期よりFPDとPVEに分けて開示します。それに伴い、FY2013の数字について遡及処理し、表示しています。
- セグメント利益は、税前利益です。
- 上記報告セグメントに配分していない全社費用(主に基礎研究又は要素研究等の研究開発費)があります。

# SPE部門地域別売上高



# 受注額・受注残高

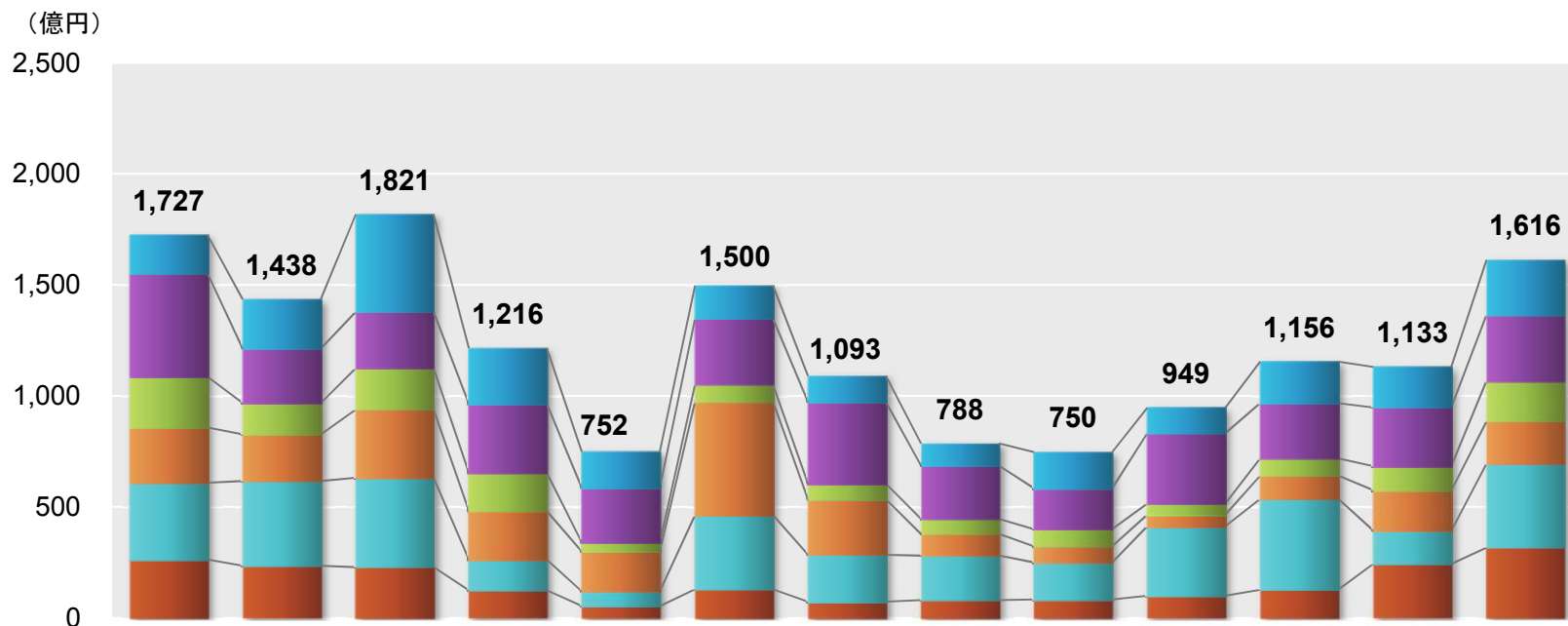
(億円)



	FY11 2Q	3Q	4Q	FY12 1Q	2Q	3Q	4Q	FY13 1Q	2Q	3Q	4Q	FY14 1Q	2Q
■ SPE受注額	1,502	1,286	1,558	1,126	735	1,449	1,064	760	669	913	1,082	977	1,541
■ FPD受注額	224	152	263	89	17	50	28	27	80	36	73	144	63
■ PVE受注額								0	0	0	0	11	11
SPE受注残高	2,155	2,288	2,289	2,207	1,667	2,201	1,886	1,577	1,187	1,426	1,416	1,645	1,989
FPD受注残高	578	510	654	618	394	278	142	122	158	148	160	255	274
PVE受注残高								0	-	84	84	76	74

FY12/4Q以前のPVEの受注額および受注残高はFPDとの合計額で表示しています。

# 地域別受注額：SPE+FPD+PVE



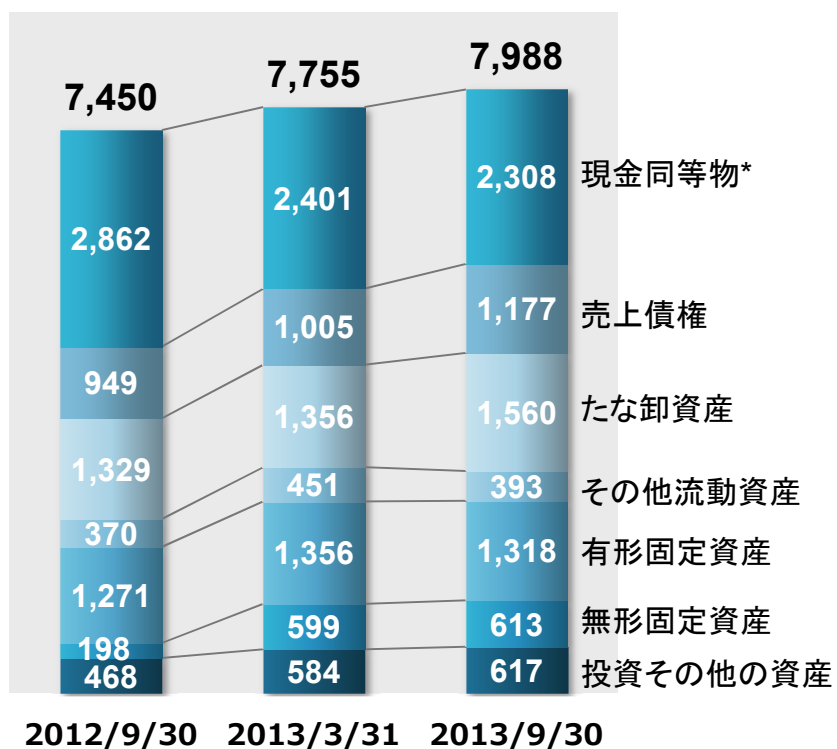
	FY11 2Q	FY11 3Q	FY11 4Q	FY12 1Q	FY12 2Q	FY12 3Q	FY12 4Q	FY13 1Q	FY13 2Q	FY13 3Q	FY13 4Q	FY14 1Q	FY14 2Q
国内	173	222	439	250	163	149	117	100	163	115	187	183	247
米国	466	245	254	311	248	297	368	240	184	317	249	264	298
欧州	228	141	186	172	39	76	70	68	77	50	77	109	182
韓国	249	210	307	219	179	511	251	97	73	52	105	182	191
台湾	346	382	403	137	66	335	210	200	167	313	410	149	378
中国・東南ア他	263	235	229	125	54	129	74	81	83	100	127	244	317



# 貸借対照表

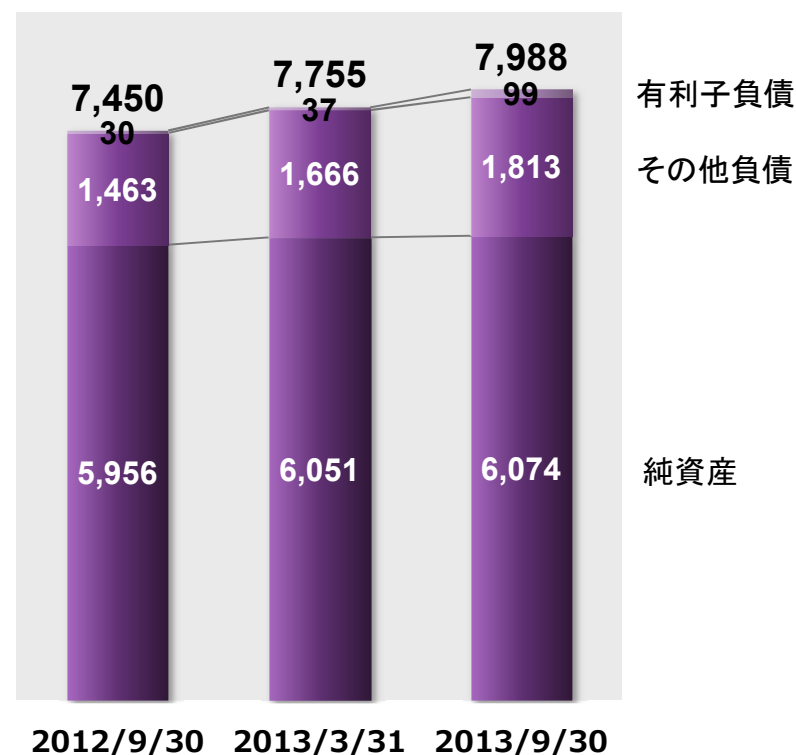
## 資産

(億円)



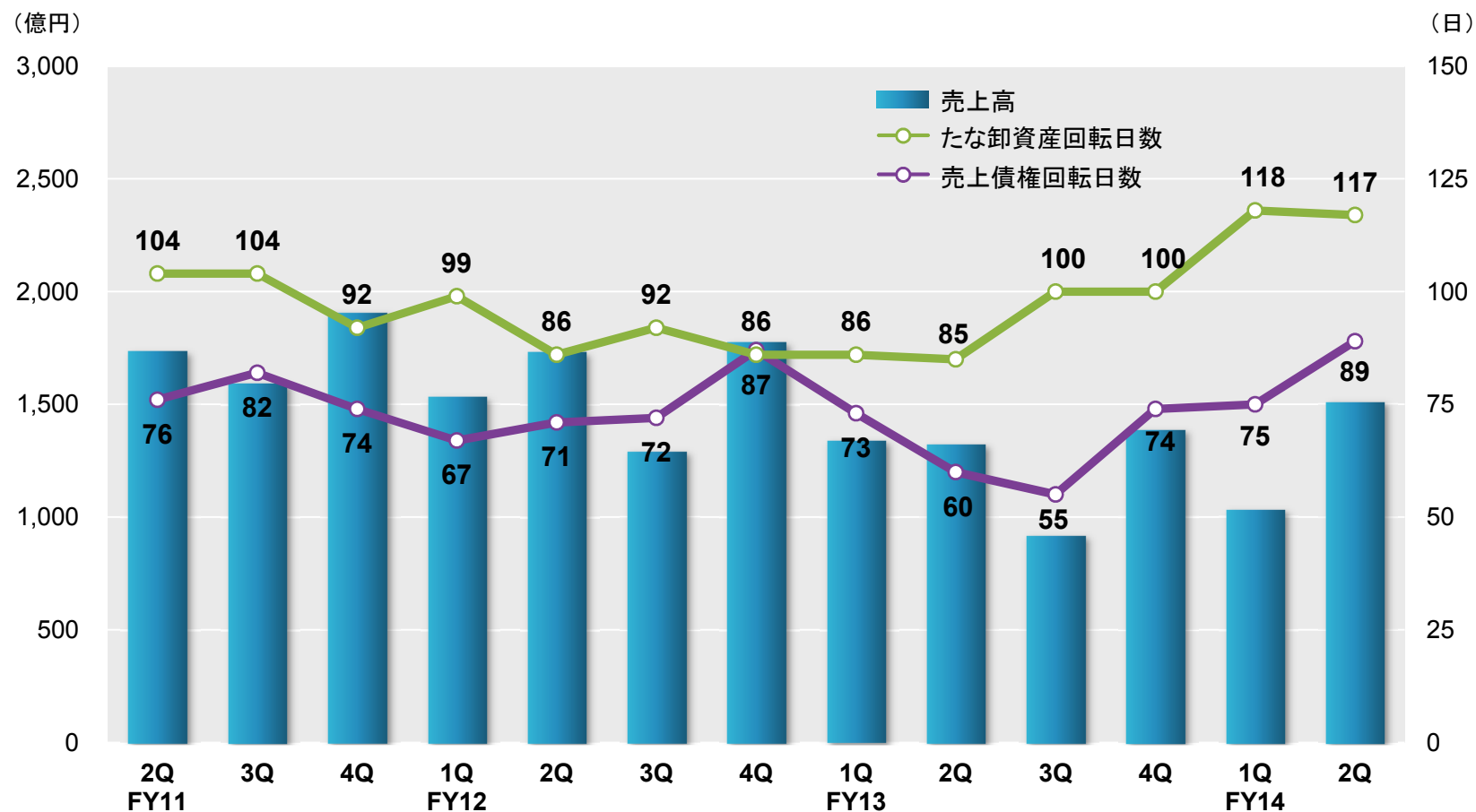
## 負債・純資産

(億円)



現金同等物\*: 現預金 + 短期投資等 (貸借対照表上の表示は有価証券)

# たな卸資産・売上債権の回転日数



回転日数 = 売上債権もしくはたな卸資産 ÷ 各四半期末までの12ヶ月間売上高 × 365

# キャッシュ・フロー

	2013年3月期 上期	2014年3月期 上期	(億円)
<b>営業キャッシュ・フロー</b>	<b>739</b>	<b>△2</b>	
税引前利益	155	△3	
減価償却費	117	127	
売上債権の減少(△増加)	546	△163	
たな卸資産の減少(△増加)	148	△203	
仕入債務の増加(△減少)	△143	90	
法人税等の支払額または還付額	△18	3	
その他	△66	145	
<b>投資キャッシュ・フロー</b>	<b>△842</b>	<b>71</b>	
設備投資	△118	△52	
企業買収に伴う株式取得等による支出	△158	-	
満期3ヵ月超の預金等の増減額	△557	139	
その他	△8	△15	
<b>財務キャッシュ・フロー</b>	<b>△64</b>	<b>11</b>	
配当金支払い	△48	△46	
その他	△16	57	
<b>現金及び現金同等物の期末残高</b>	<b>1,416</b>	<b>899</b>	
<b>満期3ヵ月超の定期預金・短期投資の期末残高</b>	<b>1,445</b>	<b>1,408</b>	
<b>現金及び現金同等物＋満期3ヵ月超の定期預金・短期投資等の期末残高</b>	<b>2,862</b>	<b>2,308</b>	

---

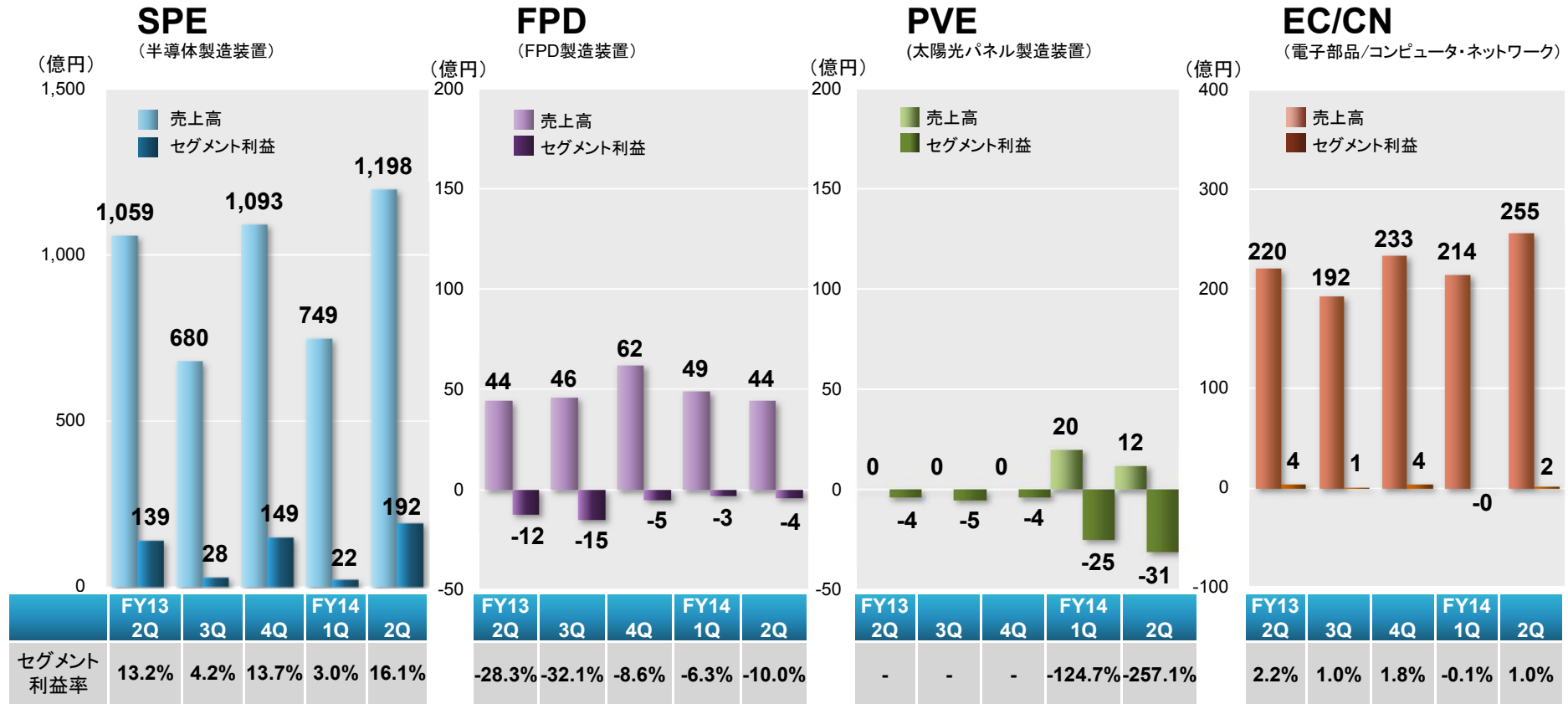
## 補足資料

# 業績サマリー

	2013年3月期			2014年3月期		(億円)
	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	
<b>売上高</b>	<b>1,324</b>	<b>919</b>	<b>1,387</b>	<b>1,034</b>	<b>1,510</b>	
SPE	1,059	680	1,093	749	1,198	
FPD	44	46	62	49	44	
PVE	0	0	0	20	12	
EC/CN	218	191	230	214	253	
その他	1	0	1	1	1	
<b>売上総利益</b>	<b>415</b>	<b>282</b>	<b>448</b>	<b>299</b>	<b>501</b>	
下段: 売上総利益率	31.4%	30.7%	32.3%	28.9%	33.2%	
<b>販管費</b>	<b>386</b>	<b>351</b>	<b>376</b>	<b>395</b>	<b>423</b>	
<b>営業利益</b>	<b>29</b>	<b>-68</b>	<b>72</b>	<b>-96</b>	<b>78</b>	
下段: 営業利益率	2.2%	-7.5%	5.2%	-9.3%	5.2%	
<b>税前利益</b>	<b>43</b>	<b>-61</b>	<b>84</b>	<b>-98</b>	<b>95</b>	
<b>当期純利益</b>	<b>3</b>	<b>-70</b>	<b>70</b>	<b>-29</b>	<b>54</b>	
研究開発費	194	174	183	179	204	
設備投資額	52	59	29	47	19	
減価償却実施額	62	66	82	63	64	

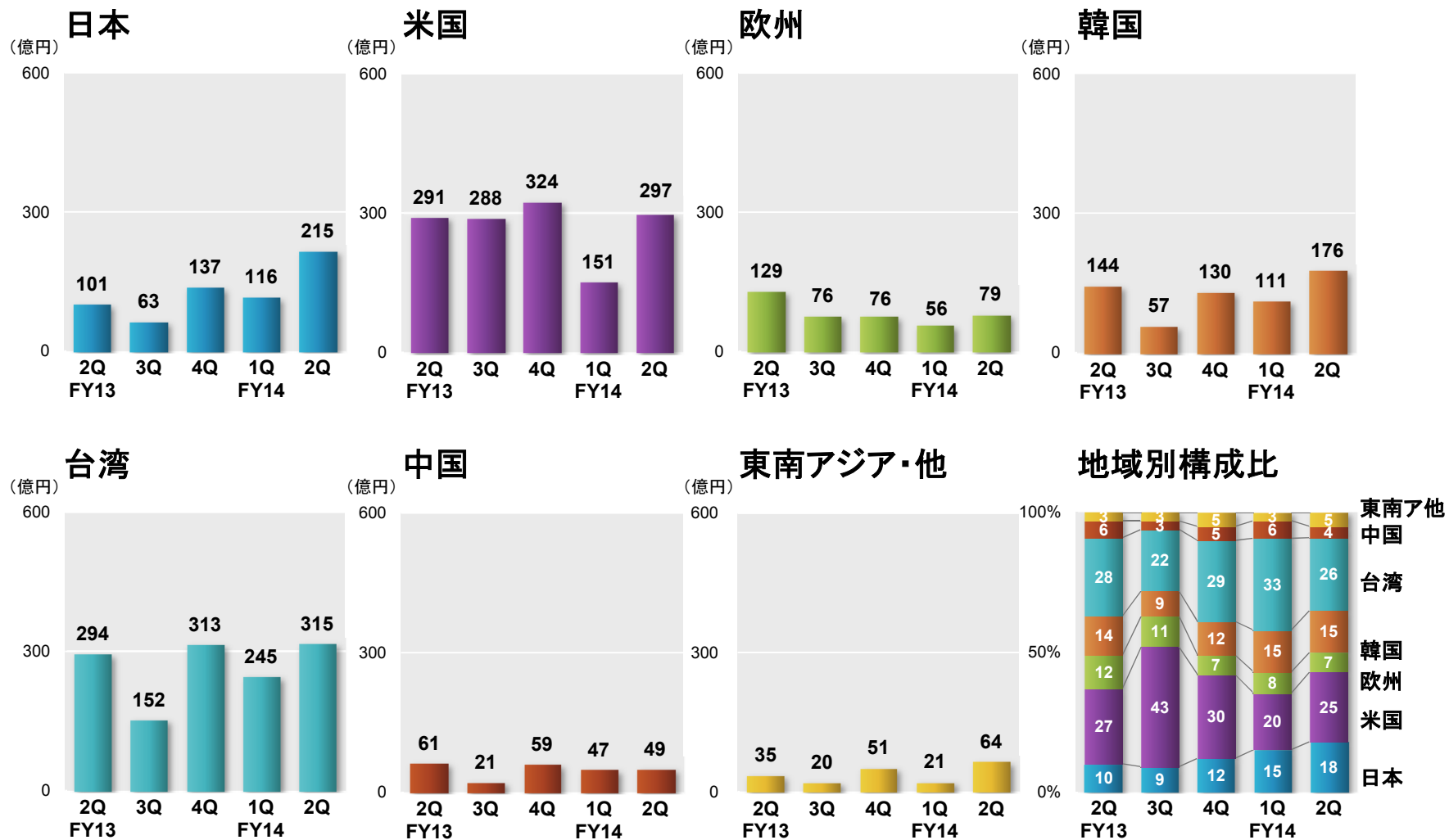
1. 当社の主力製品である半導体製造装置及びFPD製造装置の輸出売上は、原則円建てで行われます。一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。
2. 利益率および増減率は、1円単位の金額をもとに計算しています

# セグメント情報



- 従来のFPD/PVEセグメントを、当第1四半期よりFPDとPVEに分けて開示します。それに伴い、FY2013の数字について遡及処理し、表示しています。
- セグメント利益は、税前利益です。
- 上記報告セグメントに配分していない全社費用(主に基礎研究又は要素研究等の研究開発費)があります。

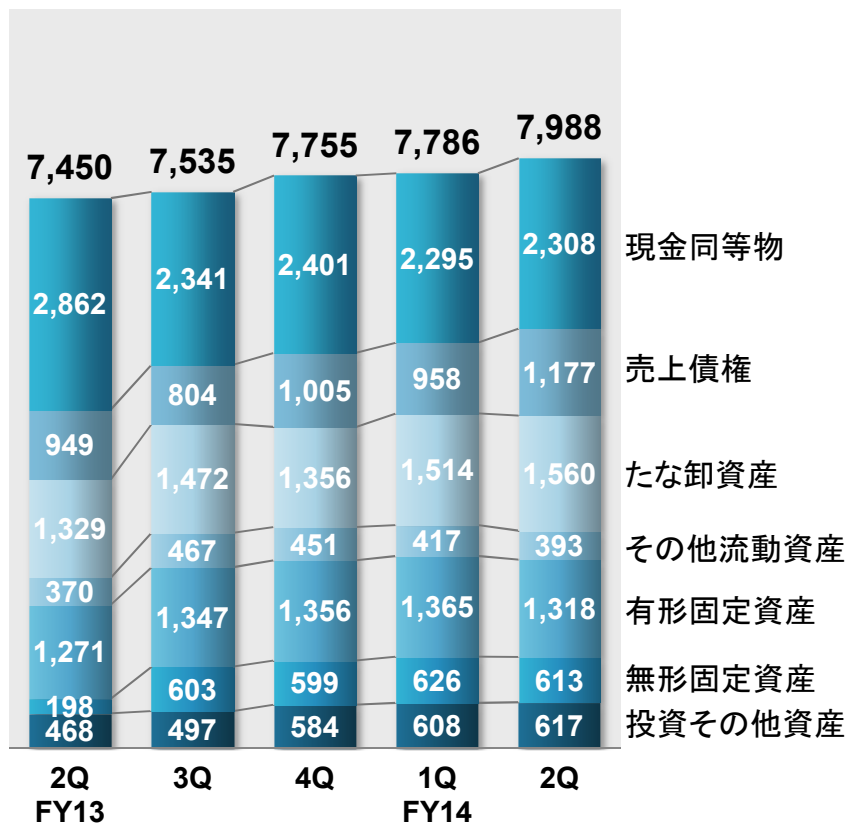
# SPE部門地域別売上高



# 貸借対照表

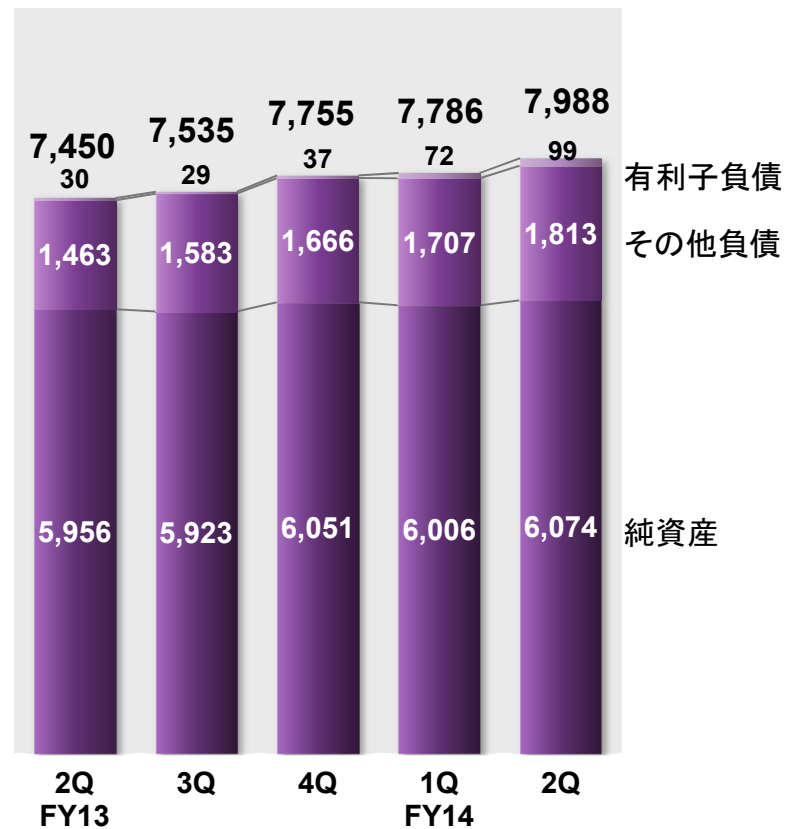
## 資産

(億円)



## 負債・純資産

(億円)



現金同等物: 現預金 + 短期投資等 (貸借対照表上の表示は「有価証券」)



# 2014年3月期 業績予想修正および 重点施策の進捗状況

代表取締役会長兼社長、CEO 東 哲郎

2013年10月29日



TOKYO ELECTRON

CORP IR/October 29, 2013



---

## 市場環境



TOKYO ELECTRON

CORP IR/October 29, 2013



# 事業環境

## ▶ 半導体設備投資

CY2013の半導体前工程(WFE)の設備投資は、前年同水準の\$30Bを見込む  
年後半より顧客の設備投資意欲がさらに高まり、受注は増加

- メモリ: ミドルエンドのスマートフォンを中心に需要が拡大  
DRAM: 微細化投資に加え、能力増強投資も活発化  
NAND: モバイル機器向けの需要が投資を牽引
- ロジック/ファウンドリ: 先端ロジック向け能力増強投資は継続

## ▶ FPD設備投資

CY2013の液晶パネル用製造装置の需要は、大型、中小型パネル向けともに、  
中国を中心に、前年比50%前後の増加を見込む。また、有機ELテレビ市場の  
立ち上がりは2016年以降であり、設備投資の本格化は2015年を見込む。

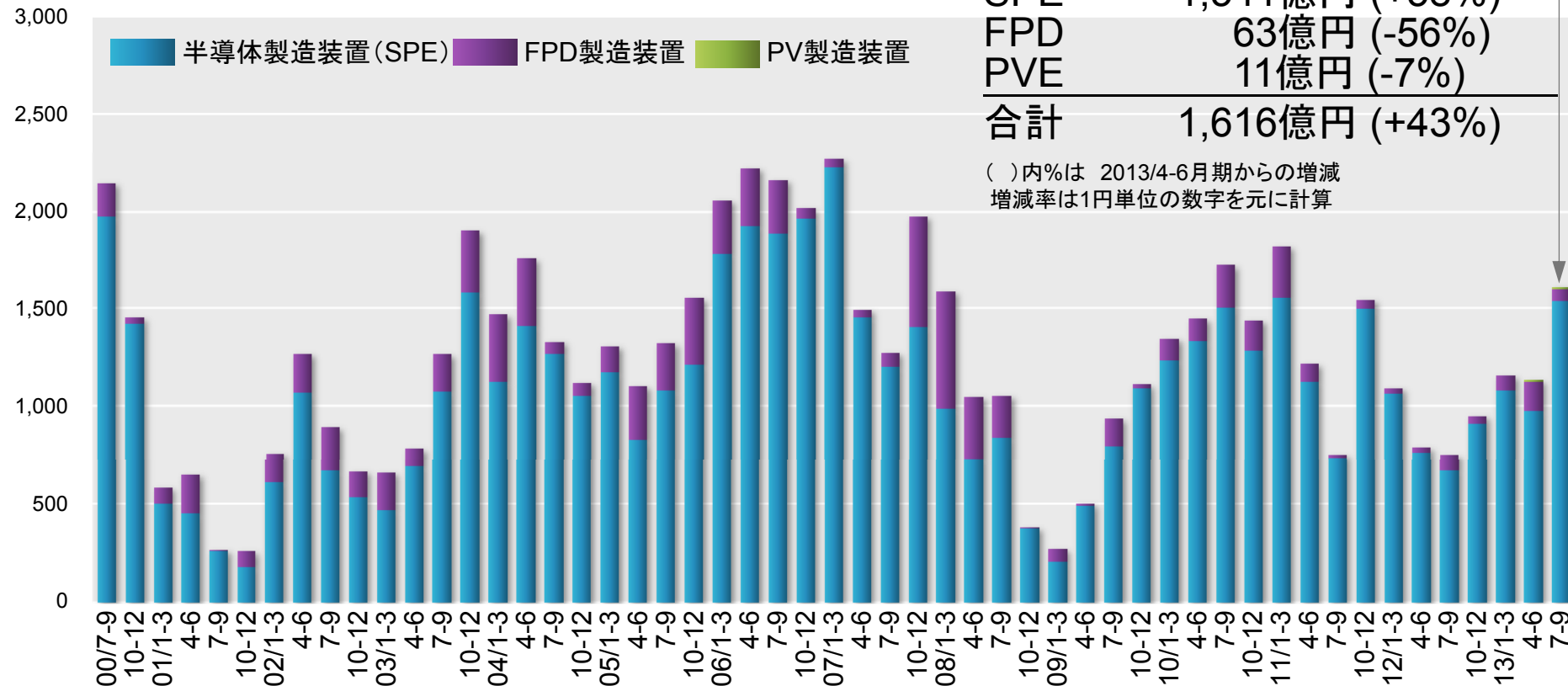
## ▶ PVE設備投資

太陽光パネル市場については、供給過剰の状態が続いており、太陽光パネル  
製造装置への需要も低迷が続いている。

(2013年10月時点での見方)

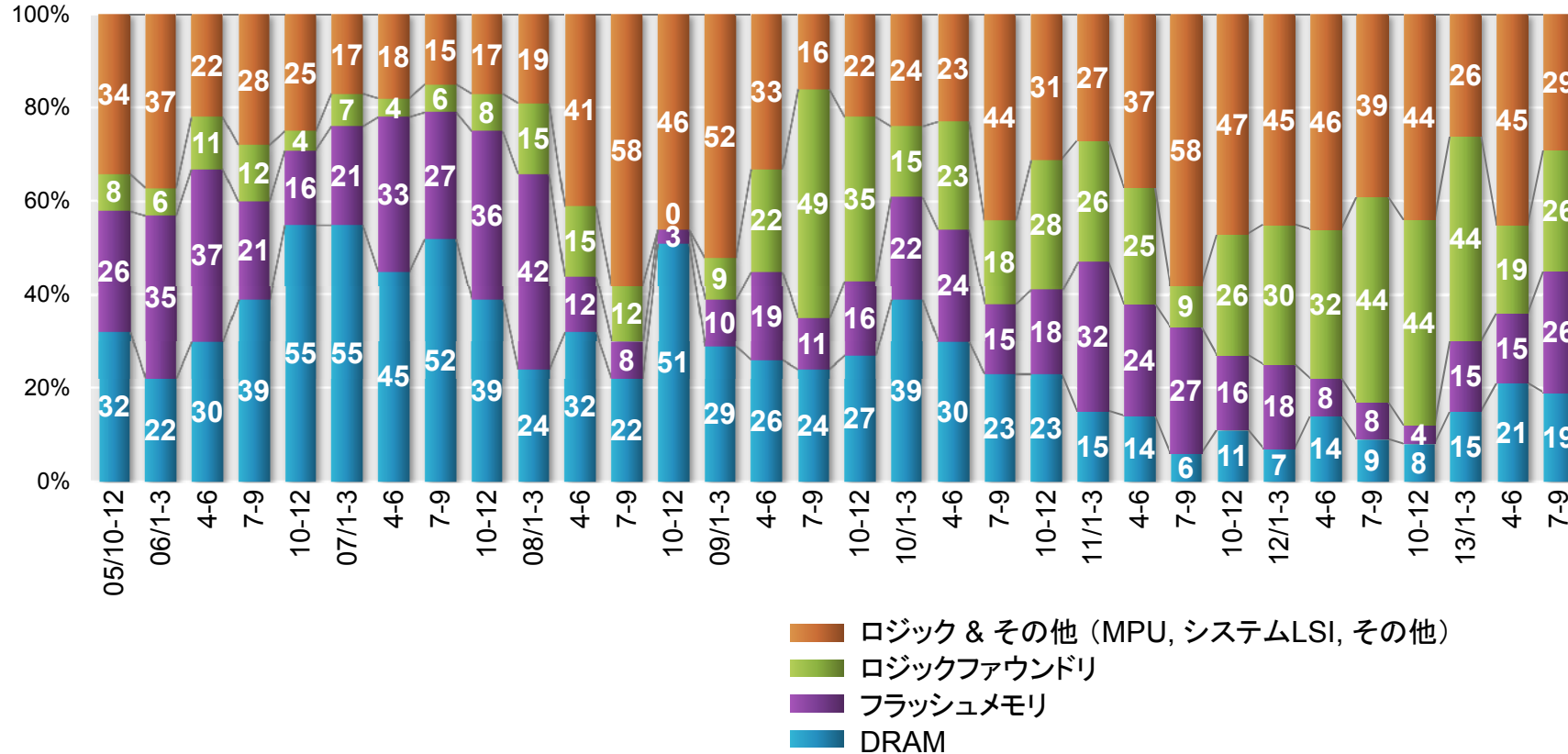
# 四半期 受注額

(億円)



2012/1-3月期以前のPV製造装置の受注額は  
FPD製造装置の値に含まれています。

# 四半期 アプリケーション別SPE受注



- ロジック & その他 (MPU, システムLSI, その他)
- ロジックファウンドリ
- フラッシュメモリ
- DRAM

グラフは装置本体受注における構成比を示しています。

---

# 2014年3月期 業績予想修正



TOKYO ELECTRON

CORP IR/October 29, 2013



# 2014年3月期 業績予想修正 (10月23日発表)

(億円)

	FY2013	FY2014					
		上期	下期		通期		通期 対前年 増減
		実績	新予想	修正額*	新予想	修正額*	
売上高	4,972	2,545	3,505	+405	6,050	+430	+22%
SPE	3,920	1,947	2,803	+403	4,750	+390	+21%
FPD	200	93	167	+7	260	-	+30%
PVE	0	32	38	-32	70	-40	-
EC/CN	846	467	498	+28	965	+75	+14%
その他	4	2	3	+3	5	+5	+12%
営業利益	125	-18	318	+73	300	+120	+174
下段: 営業利益率	2.5%	-0.7%	9.1%	+1.2pts	5.0%	+1.8pts	+2.5pts
税前利益	177	-3	323	+68	320	+120	+142
当期純利益	60	24	206	+66	230	+100	+169

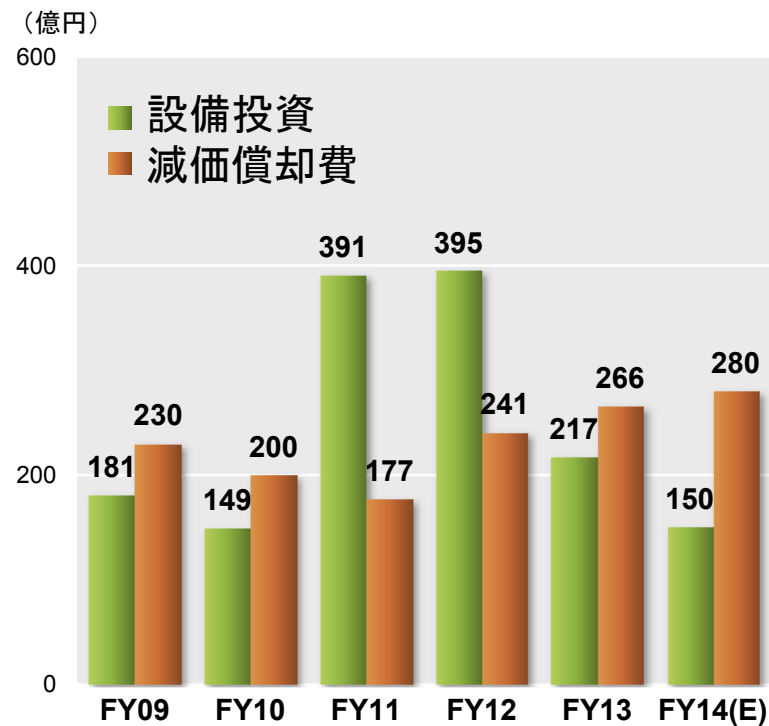
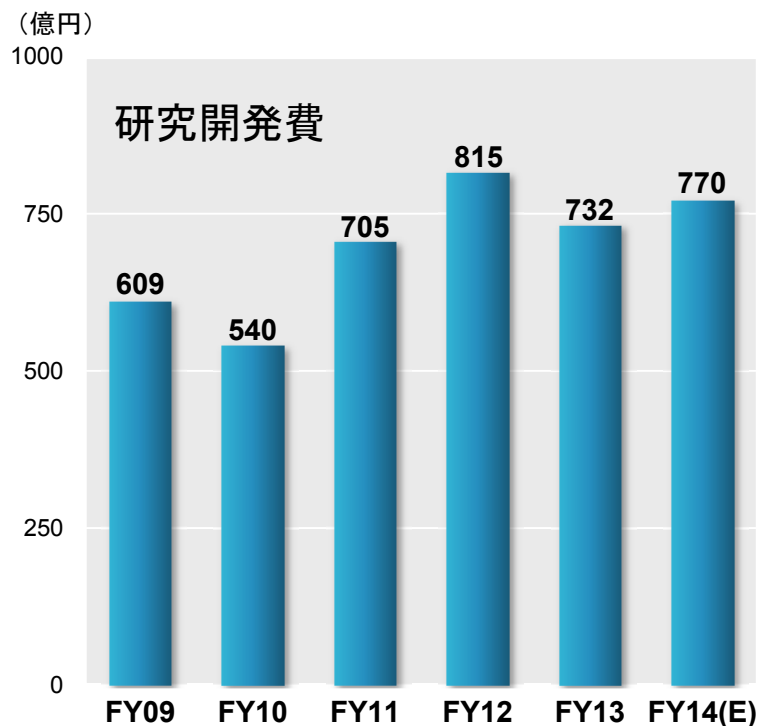
\*修正額: 2013/7/30に発表した業績予想からの修正額を示しています。

先端ロジック、メモリ向けの投資活発化により、通期業績予想を上方修正

SPE: 半導体製造装置 FPD: フラットパネルディスプレイ製造装置 PVE: 太陽光パネル製造装置 EC/CN: 電子部品/コンピュータ・ネットワーク

22

# 研究開発費・設備投資計画



- 研究開発費：変更なし
- 設備投資額：期初計画170億円 → 150億円
- 減価償却費：期初計画300億円 → 280億円









## 重点施策に関する当期の進捗

# SPE事業の進捗（強化分野）

## ▶ 洗浄装置

- 枚葉洗浄では、当社独自技術による注力分野での顧客展開が計画通り進捗。台湾、韓国において売上を拡大。
- ドライ洗浄では、微細化ニーズ対応で高シェア維持

## ➤ 幅広い製品群でソリューション提供

バッチ	枚葉		Dry洗浄	物理洗浄	
WET	WET		DRY処理		WET
			ガスケミカル	エアロゾル	スクラバー
EXPEDIUS™ 	CELLESTA™ 	ORION™  高温SPM処理	Certas™ 	ANTARES™  パーティクル除去	NS300+ 

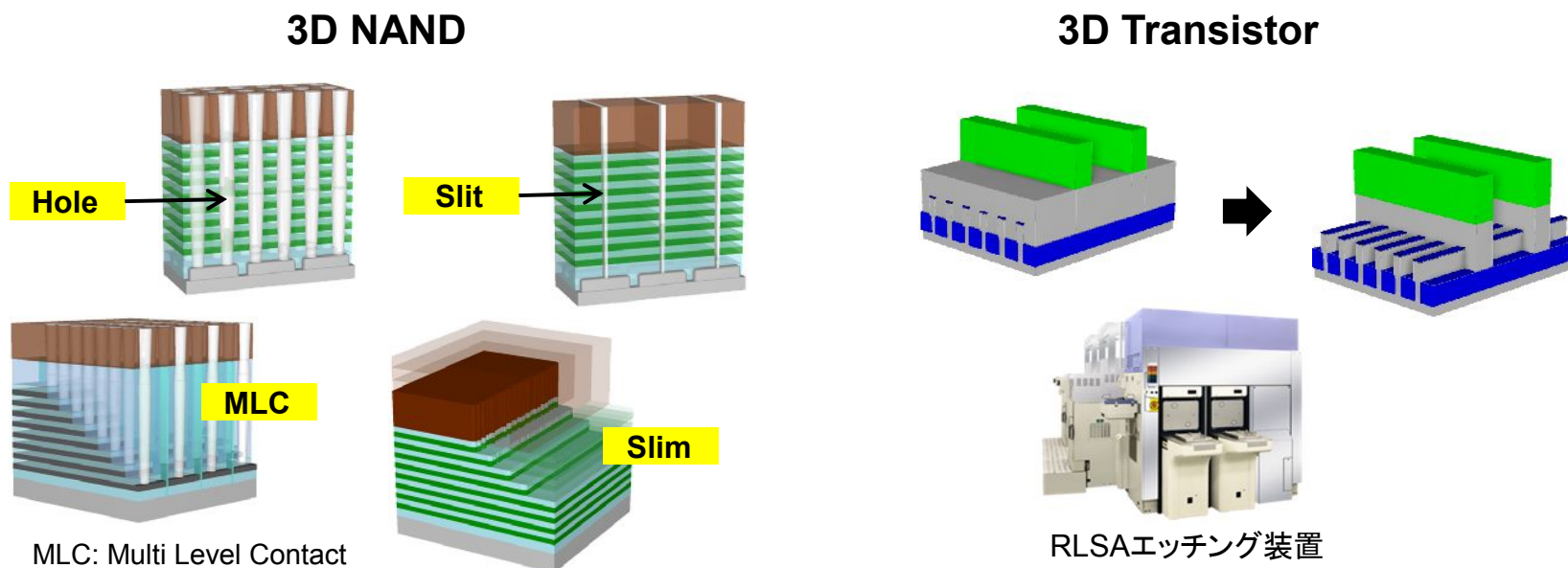
SPM: Sulfuric Acid & Hydrogen Peroxide Mixture (硫酸過水混合液)

ロジック、メモリ分野において売上とシェア拡大

# SPE事業の進捗（強化分野）

## ▶ エッチング装置

- 3D NANDの新規工程にてシェア拡大を目指す
- FinFET工程においてRLSA装置で新規に複数社のPOR獲得



3D NANDの新規工程にて、当社が強みをもつ深穴技術でシェア拡大を、FinFET工程では、低ダメージを特徴とするRLSA装置で顧客展開を図る

# SPE事業 その他ハイライト

## ▶ 熱処理成膜装置

- 独自技術が評価され大手ロジックメーカーで新規採用
- NANDにおいて高性能ALD装置(NT333)が量産採用

## ▶ STT-MRAM向けの装置開発を加速(東北大学との共同開発)

- 東北大学にて当社開発用装置の設置が完了し、開発が本格化

### STT-MRAM向け装置開発



GCIB装置  
(TEL Epion)



洗浄装置



エッチング・  
CVD装置



磁場アニール装置  
(TEL Magnetic Solutions)



酸窒化膜  
CVD装置



磁性・金属  
スパッタ装置

STT-MRAM: Spin Transfer Torque-Magnetoresistive Random Access Memory

# FPD/PVE事業の進捗

## ▶ FPD製造装置

- G8向け新型ICPエッチング装置を市場投入。高精細パネル(4K)、OLED等の新しい技術ニーズに対応する製品で収益拡大を図る。
- 中国昆山工場から本体装置を出荷。継続して顧客対応力向上と現地調達比率を高め利益向上を目指す。

## ➤ 有機EL製造装置

- 大型有機ELテレビ用パネルの本格量産は2016年以降
- 顧客の高生産性を実現するインクジェット方式の装置開発に注力

## ▶ 太陽光パネル製造装置

- 変換効率向上を早期達成するために、次世代装置開発を加速

ICP: Inductively Coupled Plasma(誘導結合プラズマ)

# サマリー

---

1. 先端ロジックおよびメモリ投資により、半導体前工程市場は、来年に向けて良好な環境が継続する見通し。
2. 7-9月期のSPE受注が1,500億円を回復。強い顧客投資計画を受けて、FY2014/3月期の通期業績予想を上方修正。
3. 洗浄事業、エッチング事業、熱処理成膜事業で顧客展開が進捗。継続して、当社独自技術で収益、シェア拡大に取り組む。

---

## ▶ 将来見通しについて

本資料に記述されている当社の業績予想、将来予測などは、当社が作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、経済情勢、半導体/FPD/PV市況、販売競争の激化、急速な技術革新への当社の対応力、安全・品質管理、知的財産権に関するリスクなど、様々な外部要因・内部要因の変化により、実際の業績、成果はこれら見通しと大きく異なる結果となる可能性があります。

## ▶ 数字の処理について

記載された金額は単位未満を切り捨て処理、比率は1円単位の金額で計算した結果を四捨五入処理しているため、内訳の計が合計と一致しない場合があります。

## ▶ 為替リスクについて

当社の主力製品である半導体製造装置及びFPD/PV製造装置の輸出売上は、原則円建てで行われます。一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。従って、収益への為替レート変動による影響は極めて軽微です。

FPD/PV:フラットパネルディスプレイ及び太陽光パネル

# 50 Years